

2023 年度日立ハイテク奨学生研究発表会 (No.2)

日時： 8月2日 (水) 13:30~15:30

会場： 総合研究棟 B204 室

発表者： 日立ハイテク奨学生

発表： 質疑応答含め各 10 分間

方式： ハイブリッド (オンライン参加者には Teams URL をお送りします。)

1. 13:30~13:40

ガラス基板上 p-NiO/n-BaSi₂ ヘテロ接合型太陽電池の作製と特性評価

竹中 晴紀 M2 (未益都甲研)

2. 13:40~13:50

Au 添加 Mn₄N エピタキシャル薄膜の作製と磁気特性の評価

堀内 拓海 M2 (未益都甲研)

3. 13:50~14:00

Zn_{1-x}GexO_y 界面層を用いた n⁺-AZO/p-BaSi₂ 太陽電池の検討

高柳 香織 M2 (未益都甲研)

4. 14:00~14:10

球面電子源のエミッション特性シミュレーション

姫田 幸毅 M2 (関口早田研)

5. 14:10~14:20

暗視野 STEM 法によるコリネ菌の Fe 分布の観察

小嶋 駿平 M2 (関口早田研)

6. 14:20~14:30

ポストアニール条件の違いによる BaSi₂ 膜の特性変化

岩井 藍 M2 (未益都甲研)

7. 14:40~14:50

固相成長 Ge 薄膜の性能改善に向けた下地層の探索

居倉 功汰 M1 (未益都甲研)

8. 14:50~15:00

液晶性半導体材料を用いた有機電気化学トランジスタの電子スピン共鳴による研究

岡部 沙代 M1 (丸本研)

9. 15:00~15:10

AgBa₂Si₃ 熱電薄膜の応用に向けた第一原理計算による伝導型制御の検討

梶原 君円 M1 (未益都甲研)

10. 15:10~15:20

STEM 画像の超解像処理による原子位置計測精度の向上

小林 明珠 M1 (五十嵐研)